

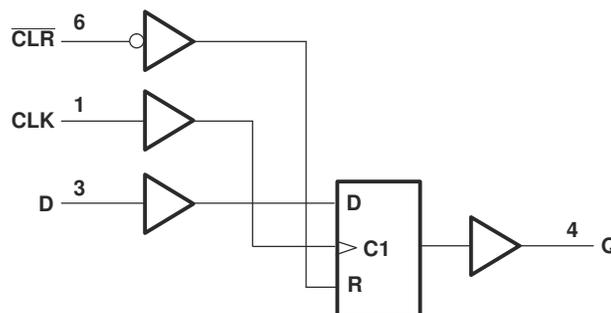
# SN54SC1G175-SEP シングル D タイプ フリップフロップ、非同期クリア付き

## 1 特長

- VID V62/26610
- 放射線 - トータルドーズ効果 (TID):
  - 50krad(Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  - 30krad(Si) まで吸収線量 (TID) 性能保証
  - すべてのウェハーロットについて、30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
- 放射線 - シングル イベント効果 (SEE):
  - 単一イベントラッチアップ (SEL) 耐性: 125°C で 50MeV-cm<sup>2</sup>/mg まで
  - シングル イベント過渡 (SET) 特性: LET = 50MeV-cm<sup>2</sup>/mg (最大値)
- 幅広い動作範囲: 1.2V ~ 5.5V
- 5.5V 耐圧入力ピン
- 標準ピン配置をサポート
- 5V または 3.3V の V<sub>CC</sub> で最大 150Mbps
- JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- 宇宙用強化プラスチック
  - 防衛および航空宇宙アプリケーションのサポート
  - 管理されたベースライン
  - Au ボンドワイヤと NiPdAu リード仕上げ
  - NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
  - 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
  - 長期にわたる製品ライフサイクル
  - 製品のトレーサビリティ

## 2 アプリケーション

- デジタル信号のイネーブルまたはディスエーブル
- インジケータ LED の制御



ロジック図

## 3 説明

SN54SC1G175-SEP デバイスは、非同期クリア ( $\overline{\text{CLR}}$ ) 入力を備えたシングル D タイプ フリップ フロップです。 $\overline{\text{CLR}}$  が HIGH の場合、入力ピン (D) からのデータは、クロック (CLK) の立ち上がりエッジで出力ピン (Q) に転送されます。 $\overline{\text{CLR}}$  が LOW の場合、クロック エッジや D のデータに関係なく、Q は LOW 状態に強制されます。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)	本体サイズ (3)
SN54SC1G175-SEP	DBV (SOT-23、6)	2.9mm × 2.8mm	2.9mm × 1.6mm

- (1) 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



## 目次

1 特長.....	1	7.3 機能説明.....	10
2 アプリケーション.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	11
3 説明.....	1	8 アプリケーションと実装.....	12
4 ピン構成および機能.....	3	8.1 使用上の注意.....	12
5 仕様.....	4	8.2 代表的なアプリケーション.....	12
5.1 絶対最大定格.....	4	8.3 電源に関する推奨事項.....	14
5.2 ESD 定格.....	4	8.4 レイアウト.....	15
5.3 推奨動作条件.....	4	9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	17
5.4 熱に関する情報.....	5	9.1 ドキュメントのサポート.....	17
5.5 電気的特性.....	5	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	17
5.6 タイミング特性.....	6	9.3 サポート・リソース.....	17
5.7 スイッチング特性.....	7	9.4 商標.....	17
5.8 代表的特性.....	7	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	17
6 パラメータ測定情報.....	8	9.6 用語集.....	17
7 詳細説明.....	10	10 改訂履歴.....	17
7.1 概要.....	10	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	18
7.2 機能ブロック図.....	10		

## 4 ピン構成および機能

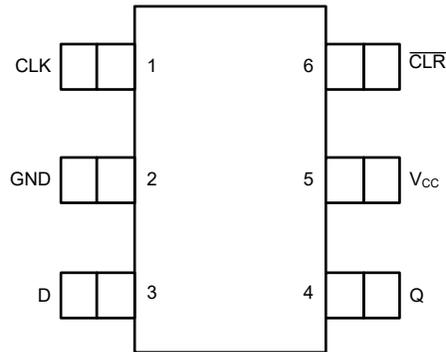


図 4-1. DBV パッケージ、6 ピン SOT-23 (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ <sup>(1)</sup>	説明
名称	番号		
CLK	1	I	クロック入力
GND	2	G	グランドピン
D	3	I	データ入力
Q	4	O	出力
V <sub>CC</sub>	5	P	正電源
CLR	6	I	非同期クリアピン

(1) 信号タイプ: I = 入力、O = 出力、G = グランド、P = 電源

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

動作周囲温度範囲を超える場合 (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧範囲	-0.5	6.5	V
V <sub>I</sub>	入力電圧範囲 <sup>(2)</sup>	-0.5	6.5	V
V <sub>O</sub>	出力電圧範囲 <sup>(2)</sup>	-0.5	V <sub>CC</sub> + 0.5	V
I <sub>IK</sub>	入力クランプ電流	V <sub>I</sub> < 0V		-50 mA
I <sub>OK</sub>	出力クランプ電流	V <sub>O</sub> < 0V		-50 mA
I <sub>O</sub>	連続出力電流			±50 mA
I <sub>O</sub>	V <sub>CC</sub> または GND を通過する連続出力電流			±100 mA
T <sub>J</sub>	接合部温度	-65	150	°C
T <sub>stg</sub>	保存温度	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、また「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件においても、本デバイスが動作することを暗黙に示すものではありません。「推奨動作条件」の範囲外でも、「絶対最大定格」の範囲内であれば、一時的な動作によってデバイスが損傷するとは限りませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

### 5.2 ESD 定格

		値	単位
V <sub>(ESD)</sub>	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 <sup>(1)</sup>	±2000
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 <sup>(2)</sup>	±1000

- (1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

### 5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

仕様	説明	条件	最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧		1.1	5.5	V
V <sub>I</sub>	入力電圧		0	5.5	V
V <sub>O</sub>	出力電圧	(High または Low 状態)	0	V <sub>CC</sub>	V
V <sub>IH</sub>	High レベル入力電圧	V <sub>CC</sub> = 1.1V~1.95V	0.65 x V <sub>CC</sub>		V
		V <sub>CC</sub> = 2.3V~2.7V	1.7		
		V <sub>CC</sub> = 3.0V~3.6V	2		
		V <sub>CC</sub> = 4.5V~5.5V	0.7 x V <sub>CC</sub>		
V <sub>IL</sub>	Low レベル入力電圧	V <sub>CC</sub> = 1.1V~1.95V	0.35 x V <sub>CC</sub>		V
		V <sub>CC</sub> = 2.3V~2.7V	0.7		
		V <sub>CC</sub> = 3.0V~3.6V	0.8		
		V <sub>CC</sub> = 4.5V~5.5V	0.3 x V <sub>CC</sub>		
I <sub>OH</sub>	High レベル出力電流	V <sub>CC</sub> = 1.65V	-4		mA
		V <sub>CC</sub> = 2.3V	-8		
		V <sub>CC</sub> = 3.0V	-16		
			-24		
		V <sub>CC</sub> = 4.5V	-32		

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

仕様	説明	条件	最小値	最大値	単位
$I_{OL}$	Low レベル出力電流	$V_{CC} = 1.65V$		4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$		8	
		$V_{CC} = 3.0V$		16	
				24	
		$V_{CC} = 4.5V$		32	
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート	$V_{CC} = 1.2V \sim 5.0V$		20	ns/V
		$V_{CC} = 1.8V \pm 0.15V$		20	
		$V_{CC} = 2.5V \pm 0.2V$		20	
		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		10	
		$V_{CC} = 5.0V \pm 0.5V$		5	
$T_A$	外気温度での動作時		-55	125	°C

## 5.4 熱に関する情報

パッケージ	ピン	熱評価基準 <sup>(1)</sup>						単位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	$\Psi_{JT}$	$\Psi_{JB}$	$R_{\theta JC(bot)}$	
DBV (SOT-23, 6)	6	329.6	244.7	217.7	142.1	216.7	-	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

## 5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	$V_{CC}$	-55°C ~ 125°C			単位
			最小値	標準値	最大値	
$V_{OH}$	$I_{OH} = -100\mu A$	1.1V ~ 5.5V	$V_{CC} - 0.1$			V
	$I_{OH} = -4mA$	1.65V	1.2			
	$I_{OH} = -8mA$	2.3V	1.9			
	$I_{OH} = -12mA$	2.7V	2.2			
	$I_{OH} = -16mA$	3V	2.4			
	$I_{OH} = -24mA$	3V	2.3			
	$I_{OH} = -32mA$	4.5V	3.8			
$V_{OL}$	$I_{OL} = 100\mu A$	1.1V ~ 5.5V	0.15			V
	$I_{OL} = 4mA$	1.65V	0.45			
	$I_{OL} = 8mA$	2.3V	0.3			
	$I_{OL} = 12mA$	2.7V	0.4			
	$I_{OL} = 16mA$	3V	0.4			
	$I_{OL} = 24mA$	3V	0.55			
	$I_{OL} = 32mA$	4.5V	0.55			
$I_I$	$V_I = V_{CC}$ または GND	$V_{CC} = 0V \sim 5.5V$	$\pm 5$			$\mu A$
$I_{OFF}$	$V_I$ または $V_O = V_{CC}$	$V_{CC} = 0V$	$\pm 10$			$\mu A$
$I_{CC}$	$V_I = V_{CC}$ または GND、 $I_O = 0$	$V_{CC} = 1.1V \sim 5.5V$	10			$\mu A$
$\Delta I_{CC}$	1つの入力は $V_{CC} - 0.6V$ 、その他の入力は $V_{CC}$ または GND	3.0V ~ 5.5V	500			$\mu A$
$C_I$	$V_I = V_{CC}$ または GND	3.3V	3.5			pF

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V <sub>CC</sub>	-55°C ~ 125°C			単位
			最小値	標準値	最大値	
C <sub>O</sub>	V <sub>O</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	3.3V				pF

## 5.6 タイミング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	説明	条件	V <sub>CC</sub>	-55°C ~ 125°C			単位
				最小値	標準値	最大値	
f <sub>clock</sub>	クロック周波数		1.2V ± 0.1V			12	MHz
			1.5V ± 0.12			63	
			1.8V ± 0.15V			83	
			2.5V ± 0.2V			79	
			3.3V ± 0.3V			88	
			5V ± 0.5V			92	
t <sub>w</sub>	パルス幅	CLR̄ が Low	1.2V ± 0.1V	8			ns
			1.5V ± 0.12V	8			
			1.8V ± 0.15V	8			
			2.5 ± 0.2V	8			
			3.3V ± 0.3V	8			
			5V ± 0.5V	8			
		CLK が High または Low	1.2V ± 0.1V	3			ns
			1.5V ± 0.12V	3			
			1.8V ± 0.15V	3			
			2.5 ± 0.2V	2			
			3.3V ± 0.3V	2			
			5V ± 0.5V	2			
t <sub>su</sub>	CLK ↑ 前のセットアップ時間	CLK ↑ 前のデータ	1.2V ± 0.1V	25			ns
			1.5V ± 0.12V	14			
			1.8V ± 0.15V	9			
			2.5 ± 0.2V	6			
			3.3V ± 0.3V	6			
			5V ± 0.5V	6			
	CLR̄ 非アクティブ	1.2V ± 0.1V	23			ns	
		1.5V ± 0.12V	7				
		1.8V ± 0.15V	5				
		2.5 ± 0.2V	6				
		3.3V ± 0.3V	5				
		5V ± 0.5V	4				
t <sub>H</sub>	ホールド時間	CLK ↑ 後のデータ	1.2V ± 0.1V	0			ns
			1.5V ± 0.12V	0			
			1.8V ± 0.15V	0			
			2.5 ± 0.2V	0			
			3.3V ± 0.3V	0			
			5V ± 0.5V	0			

## 5.7 スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」を参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	$V_{CC}$	-55°C ~ 125°C			単位
					最小値	標準値	最大値	
$t_{pd}$	CLK	Q	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$			112	ns
				$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$			26.4	
				$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$			17.3	
				$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$			9.7	
				$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$			6.9	
				$5\text{V} \pm 0.5\text{V}$			4.9	
			$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$			17.8	
				$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$			10	
			$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$			7.3	
				$5\text{V} \pm 0.5\text{V}$			5.4	
$t_{pd}$	$\overline{\text{CLR}}$	Q	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$			122	ns
				$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$			26.7	
				$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$			18.4	
				$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$			10.2	
				$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$			7.2	
				$5\text{V} \pm 0.5\text{V}$			4.7	
			$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$			19	
				$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$			10.5	
			$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$			7.7	
				$5\text{V} \pm 0.5\text{V}$			5.3	

## 5.8 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)

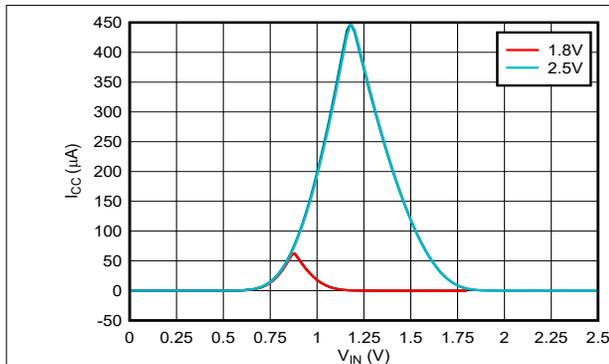


図 5-1. 入力電圧に対する電源電流、1.8V および 2.5V 電源

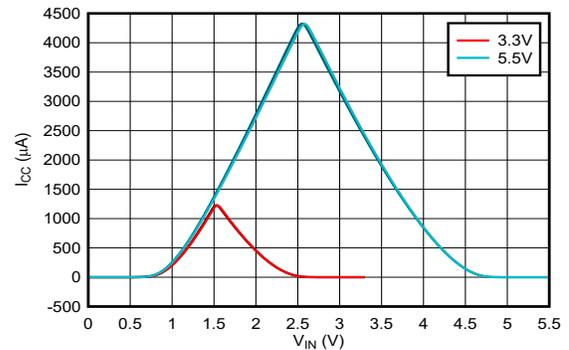


図 5-2. 入力電圧に対する電源電流、3.3V および 5.5V 電源

## 6 パラメータ測定情報

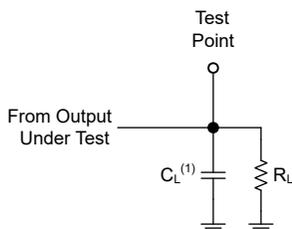
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR  $\leq$  1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_f \leq 2.5\text{ns}$ 。

クロック入力の  $f_{\text{max}}$  は、入力デューティサイクルが 50% のときの測定値です。

出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。

表 6-1. プッシュプル出力

$V_{CC}$	$V_t$	$R_L$	$C_L$	$\Delta V$
1.2V $\pm$ 0.1V	$V_{CC}/2$	2k $\Omega$	15pF	0.1V
1.5V $\pm$ 0.12V	$V_{CC}/2$	2k $\Omega$	15pF	0.1V
1.8V $\pm$ 0.15V	$V_{CC}/2$	1k $\Omega$	15pF/30pF	0.15V
2.5V $\pm$ 0.2V	$V_{CC}/2$	500 $\Omega$	15pF/30pF	0.15V
3.3V $\pm$ 0.3V	1.5V	500 $\Omega$	15pF/50pF	0.3V
5.0V $\pm$ 0.5V	1.5V	500 $\Omega$	15pF/50pF	0.3V



(1)  $C_L$  にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 6-1. プッシュプル出力のための負荷回路

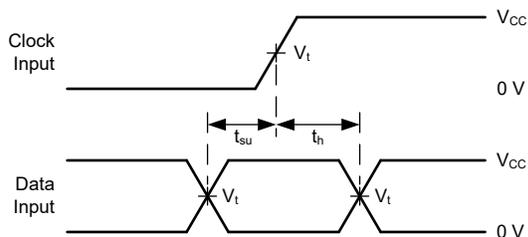


図 6-3. 電圧波形、セットアップ時間およびホールド時間

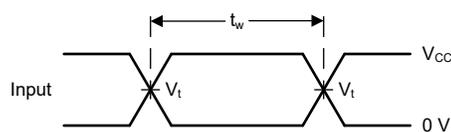
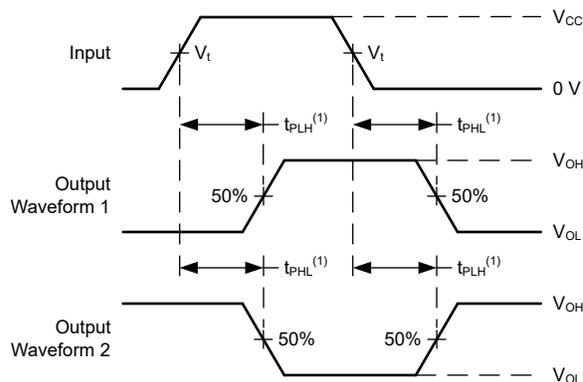
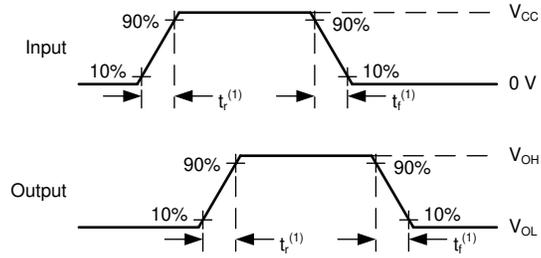


図 6-2. 電圧波形、パルス幅



(1)  $t_{PLH}$  と  $t_{PHL}$  の大きい方が  $t_{pd}$  に相当します。

図 6-4. 電圧波形、伝搬遅延



(1)  $t_r$  と  $t_f$  の大きい方が  $t_p$  に相当します。

図 6-5. 電圧波形、入力および出力の遷移時間

## 7 詳細説明

### 7.1 概要

SN54SC1G175-SEP デバイスは、非同期 クリア ( $\overline{\text{CLR}}$ ) 入力を備えたシングル D タイプ フリップ フロップです。 $\overline{\text{CLR}}$  が HIGH の場合、入力ピン (D) からのデータは、クロック (CLK) の立ち上がりエッジで出力ピン (Q) に転送されます。 $\overline{\text{CLR}}$  が LOW の場合、クロック エッジや D のデータに関係なく、Q は LOW 状態に強制されます。

### 7.2 機能ブロック図

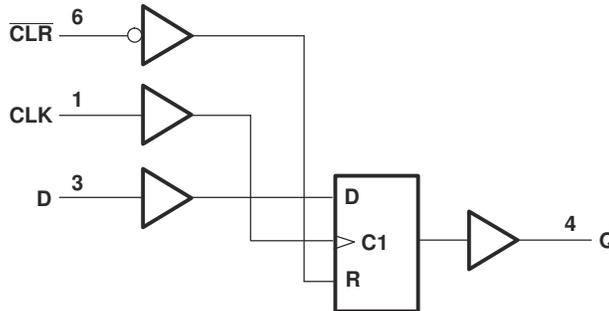


図 7-1. 論理図 (正論理)

### 7.3 機能説明

#### 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにしておく必要があります。

#### 7.3.2 標準 CMOS 入力

このデバイスには、標準 CMOS 入力 that 搭載されています。標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は電気的特性に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ( $R = V \div I$ ) を使用して計算されます。

標準 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。

動作中は、標準 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、 $V_{CC}$  または GND に終端させる必要があります。システムが入力を常にアクティブに駆動している訳ではない場合、システムが入力をアクティブに駆動していないときに有効な入力電圧を与えるため、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加できます。抵抗値は複数の要因で決まりますが、10k $\Omega$  の抵抗を推奨します。通常はこれですべての要件を満たします。

#### 7.3.3 クランプダイオード構造

図 7-2 は、このデバイスの入力と出力には負のクランプ ダイオードのみがあることを示しています。

#### 注意

絶対最大定格表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

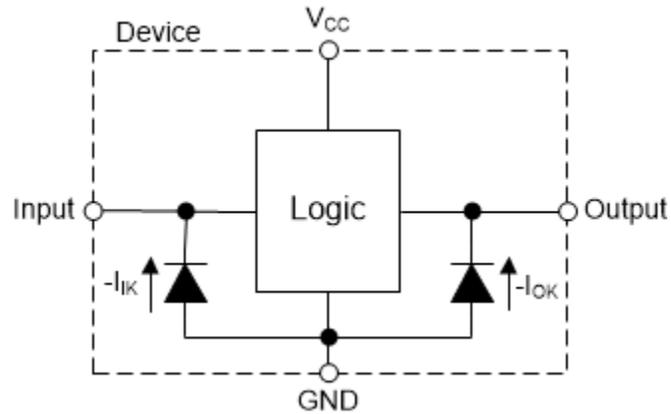


図 7-2. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電氣的配置

## 7.4 デバイスの機能モード

機能表 に、SN54SC1G175-SEP の機能モードを示します。

表 7-1. 機能表

入力 <sup>(1)</sup>			出力 Q <sup>(2)</sup>
CLR	CLK	D	
H	↑	L	L
H	↑	H	H
H	H または L	X	Q <sub>0</sub>
L	X	X	L

- (1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドントケア
- (2) H = High に駆動、L = Low に駆動、Z = 高インピーダンス状態

## 8 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 8.1 使用上の注意

複数の SN54SC1G175-SEP デバイスを組み合わせて使用して、任意の長さのシフトレジスタを作成できます。この例では、4 つの SN54SC1G175-SEP デバイスを使用して 4 ビット シリアル シフトレジスタを形成しています。すべての CLK 入力を共通のクロックパルスに接続して 1 つのデバイスの各出力を次のデバイスに接続すると、必要に応じて 4 ビット値を保存およびロードできます。シリアル入力データを目的の各メモリ ビットに設定して、4 ビット値 1101 をメモリにロードし、各ビットにクロックパルスを送信することにより、保存されているすべてのビットを左から右 (A→B→C→D) に順に移動します

### 8.2 代表的なアプリケーション

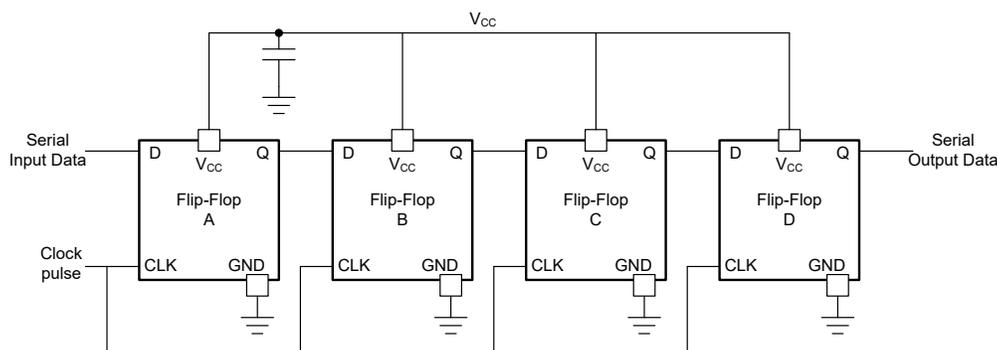


図 8-1. 4 ビット シリアル シフトレジスタ

## 8.2.1 設計要件

SN54SC1G175-SEP デバイスは CMOS 技術を使用し、平衡型出力ドライブを採用しています。上限値を超える電流が流れる可能性があるため、バスが競合しないように注意します。

SN54SC1G175-SEP により、デジタル制御信号を使用して、アナログ信号とデジタル信号のスイッチング制御が可能になります。最適な動作を行うには、すべての入力信号を 0V または  $V_{CC}$  のいずれかにできるだけ近い電位に維持してください。

### 8.2.1.1 電源に関する考慮事項

求める電源電圧が「電気的特性」で規定されている範囲内であることを確認します。「電気的特性」セクションに記載されているように、電源電圧は本デバイスの電気的特性を決定づけます。

正電圧の電源は、SN54SC1G175-SEP のすべての出力によってソースされる総電流、「電気的特性」に記載された静的消費電流 ( $I_{CC}$ ) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給する必要があります。ロジック デバイスは、正の電源から供給される電流のみをソースできます。「絶対最大定格」に記載された  $V_{CC}$  総電流の最大値を超えないようにしてください。

グラウンドは、SN54SC1G175-SEP のすべての出力によってシンクされる総電流、「電気的特性」に記載された消費電流 ( $I_{CC}$ ) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクする必要があります。ロジック デバイスは、グラウンド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載された GND 総電流の最大値を超えないようにしてください。

SN54SC1G175-SEP は、データシートの仕様をすべて満たしつつ、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することもできますが、50pF を超えることは推奨しません。

SN54SC1G175-SEP は、「電気的特性」表に定義されている出力電圧および電流 ( $V_{OH}$  および  $V_{OL}$ ) で、 $R_L \geq V_O / I_O$  で記述される合計抵抗の負荷を駆動できます。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と  $V_{CC}$  ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、CMOS の消費電力と Cpd の計算アプリケーション ノート に記載された情報を使って計算できます。

温度の上昇は、標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性アプリケーション ノート に記載された情報を使って計算できます。

#### 注意

絶対最大定格に記載された最大接合部温度 ( $T_{J(max)}$ ) は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。絶対最大定格に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

### 8.2.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、 $V_{IL(max)}$  を超えるとロジック LOW と見なされ、 $V_{IH(min)}$  を超えるとロジック HIGH と見なされます。「絶対最大定格」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 $V_{CC}$  またはグラウンドに終端させる必要があります。入力がまったく使われていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が HIGH の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が LOW の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN54SC1G175-SEP へのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により 10k $\Omega$  の抵抗値がしばしば使用されます。

SN54SC1G175-SEP は CMOS 入力を備えているため、正しく動作するには、「電気的特性」の表で定義されているように、速い入力遷移が必要です。入力遷移が遅いと発振が発生し、消費電力の増大やデバイスの信頼性の低下を招くことがあります。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」を参照してください。

### 8.2.1.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 HIGH 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の  $V_{OH}$  仕様が規定されたように出力電圧が低下します。グランド電圧を使用して、出力 LOW 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の  $V_{OL}$  仕様が規定されたように出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これは、過電流やデバイスへの損傷を引き起こす可能性があります。

同じ入力信号を持つ同一デバイス内の 2 つのチャンネルを並列に接続することにより、出力駆動の強度を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を  $V_{CC}$  またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

### 8.2.2 詳細な設計手順

#### 1. 推奨入力条件:

- 立ち上がり時間と立ち下がり時間の仕様については、「推奨動作条件」表の  $\Delta t/\Delta v$  を参照してください。
- 規定された High および Low レベルについては、「推奨動作条件」表の  $V_{IH}$  および  $V_{IL}$  を参照してください。
- 入力および出力は過電圧許容で、任意の有効な  $V_{CC}$  において最高 5.5V に対応できます。

#### 2. 推奨出力条件:

- 負荷電流は  $\pm 50\text{mA}$  を超えないこと。

#### 3. 周波数選択の基準:

- 周波数がデバイスの消費電力に及ぼす影響は、アプリケーション ノート『[CMOS の消費電力と Cpd の計算](#)』で調べる必要があります。
- トレース抵抗と容量を追加すると、最大周波数能力が低下する可能性があります。レイアウトセクションに記載されているレイアウト手法に従ってください。

### 8.2.3 アプリケーション曲線

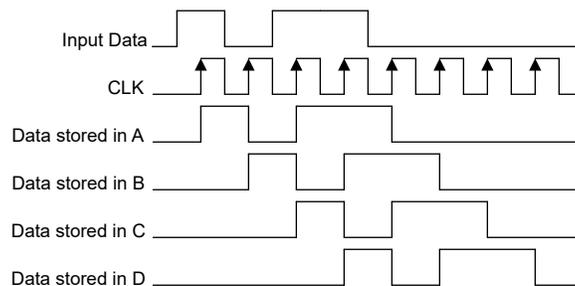


図 8-2. アプリケーション タイミング チャート

表 8-1. 保存済みのデータ値

シリアル入力データ	保存された A	保存された B	保存された C	保存された D
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
0	1	1	0	1

### 8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。

電源の外乱を防止するため、各  $V_{CC}$  端子に適切なバイパス コンデンサを配置することを確認します。SN54SC1G175-SEP には、 $0.1\mu\text{F}$  バイパス コンデンサを推奨します。異なる周波数のノイズを除去するため、複数のバイパス コンデンサを並列に配置します。通常、 $0.1\mu\text{F}$  と  $1\mu\text{F}$  の値のコンデンサを並列にして使います。

## 8.4 レイアウト

### 8.4.1 レイアウトのガイドライン

- バイパス コンデンサの配置
  - デバイスの正電源端子の近くに配置
  - 電氣的に短いグラウンド帰還パスを提供
  - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
  - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
  - $8\text{mil}$ ~ $12\text{mil}$  のトレース幅
  - 伝送ラインの影響を最小化する  $12\text{cm}$  未満の長さ
  - 信号トレースの  $90^\circ$  のコーナーは避ける
  - 信号トレースの下に、途切れのないグラウンド プレーンを使用
  - 信号トレース周辺の領域をグラウンドでフラッド フィル
  - 平行配線は、3 倍以上の誘電体厚で分離する必要があります
  - $12\text{cm}$  を超えるパターン用
    - インピーダンス制御トレースを使用
    - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
    - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

### 8.4.2 レイアウト例

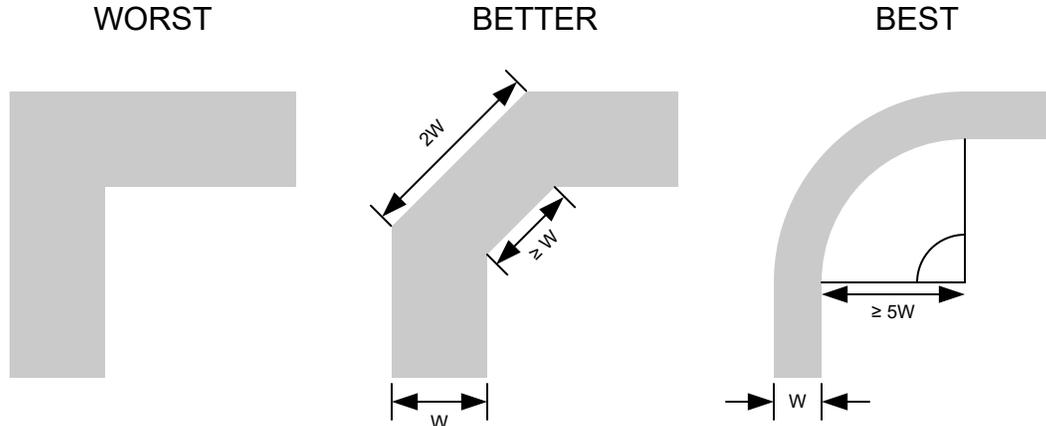


図 8-3. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー

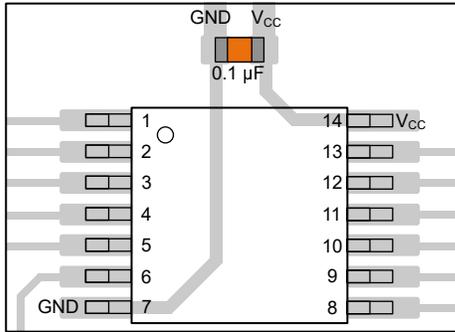


図 8-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

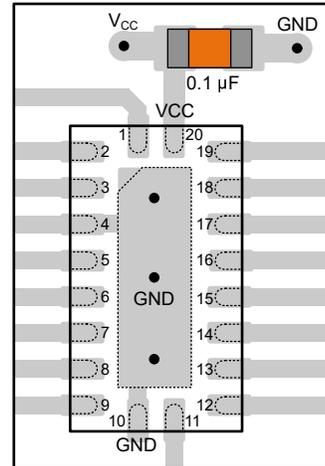


図 8-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

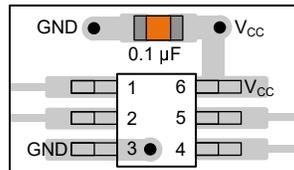


図 8-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

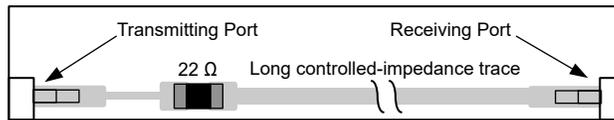


図 8-7. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介합니다。

### 9.1 ドキュメントのサポート

#### 9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[CMOS の消費電力と  \$C\_{pd}\$  の計算](#)』アプリケーションノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ロジック設計](#)』アプリケーションノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)』アプリケーションノート

### 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.  
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
February 2026	*	初版リリース

## 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月